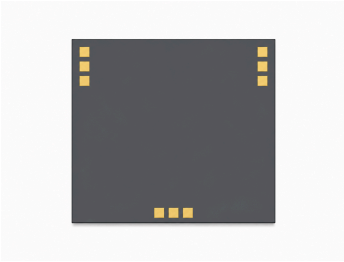


2000–18000 MHz Die divisore di potenza GaAs IPD a 2 vie e 0°

Isolamento: 20 dB (tipico); VSWR di ingresso: 1.3 (tipico); VSWR di uscita: 1.3 (tipico). Dimensioni del die: 2.12 × 1.9 × 0.1 mm.



Caratteristiche RF · TA = +25 °C

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Valore	Unità
Frequenza operativa	-	2000	-	18000	2000–18000	MHz
Isolamento	-	-	20	-	-	dB
VSWR di ingresso	-	-	1.3	-	-	-
VSWR di uscita	-	-	1.3	-	-	-

Valori limite

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Potenza di ingresso massima	-	-	-	30	dBm

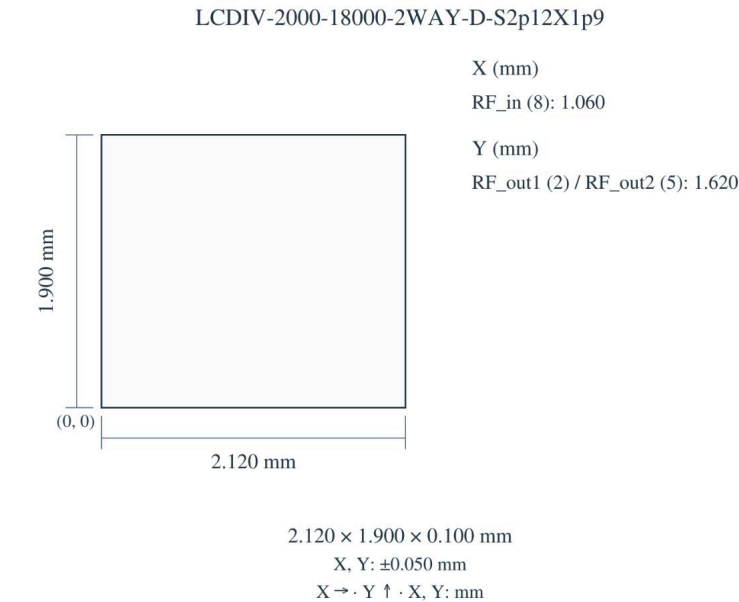
Condizioni ambientali

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Temperatura di stoccaggio	-	-65	-	150	°C
Temperatura operativa	-	-55	-	85	°C

Dimensioni del die

Parametro	Valore	Unità
Dimensioni del die	2.12 × 1.9 × 0.1	mm

Disegno dimensionale meccanico



Tutte le dimensioni sono espresse in mm [in].

Assegnazione delle piazzole di bonding

Terminali	Simbolo	Funzione	Note
1, 3, 4, 6, 7, 9	GND	Massa; bonding non necessario	-
2	RFout1	Uscita RF	1
5	RFout2	Uscita RF	2
8	RFin	Ingresso RF	-

Pubblicazione corrente · 1.3 · 2026-10-27. Aggiornamento della descrizione o dei contenuti editoriali. Sostituisce la revisione 1.2.

Ambito del riferimento meccanico

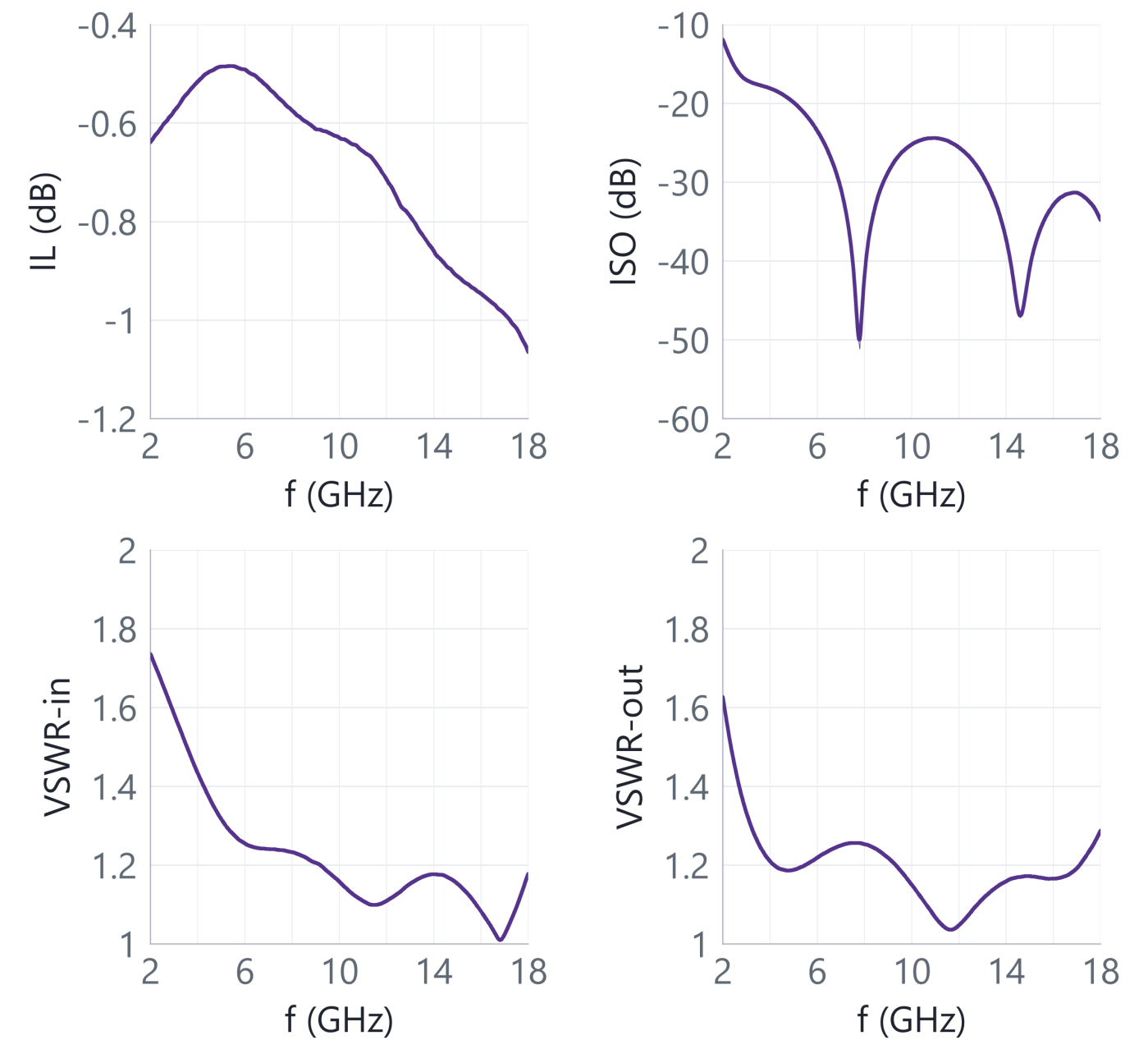
Riferimenti dimensionali in mm ricavati dalla documentazione di origine. Informazioni parziali; non costituiscono un disegno completo di fabbricazione o di wire bonding.

Curve di prestazione

Grafici tratti dalla scheda tecnica originale. Consultare ogni figura insieme alle condizioni operative indicate.

Perdita di inserzione; Isolamento; Adattamento d’ingresso; Adattamento d’uscita.

Grafico ridisegnato dalla figura originale; i valori letti sono approssimativi.



[Fonte](#)

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L’offerta approvata e la documentazione d’ordine definiscono la configurazione fornita.